

CONTRÔLE CONTINU : ÉLÉMENTS D'ÉLECTRONIQUE

Durée: 2H

2016-2017

Exercice 1:

On considère les quadripôles Q_T et Q_N de la figure 1. Notez bien qu'il faut distinguer entre z minuscule et Z majuscule lors de présentation des résultats.

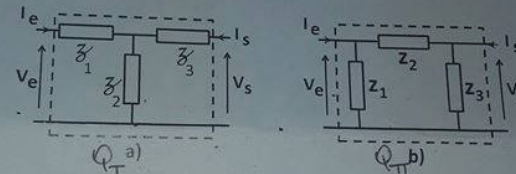


Figure 1: Le quadripôle Q_T a) et le quadripôle équivalent Q_N b)

1. Déterminer les paramètres impédances $[Z]_T$, du quadripôle Q_T de la figure 1-a.
2. Déterminer les paramètres impédances $[Z]_N$, du quadripôle Q_N de la figure 1-b.
3. Trouver les trois relations $z_i = f(Z_1, Z_2, Z_3)$ pour que $[Z]_T = [Z]_N$. Conclure.

Exercice 2:

On propose le filtre de la figure 2

1. Quel est le degré du filtre proposé ?
2. Par une analyse rapide, déterminer le comportement fréquentiel du filtre.
3. Calculer la fonction de transfert $H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e}$.
4. Tracer les diagrammes de Bode du filtre. Conclure.

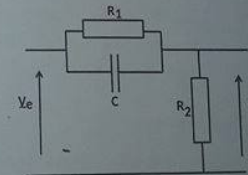


Figure 2: filtre à étudier $C = 10\mu F$, $R_1 = 1 K\Omega$ et $R_2 = 111,11 \Omega$

Exercice 3:

Soit le circuit de la figure 3; la tension d'entrée est supposée sinusoïdale :

$$V_e = E_M \sin(\omega t)$$

1. On suppose au départ que la diode est idéale (1^{ère} approximation):
Déterminer la tension de sortie V_s , et tracer la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$.
2. Refaire la même question en tenant compte de la tension seuil et la résistance dynamique de la diode (V_{seuil} , R_d) (3^{ème} approximation).

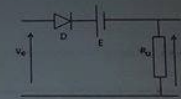


Figure 3: Circuit à diode

Exercice 4:

Soit le circuit à base du transistor bipolaire NPN présenté sur la figure 4. Il s'agit du transistor 2N1711, dont les caractéristiques sont données sur le document réponse 5.

On donne: $V_{BB} = 1.25\text{ V}$, $R_B = 12\text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 12\text{ V}$ et $R_C = 820\Omega$.

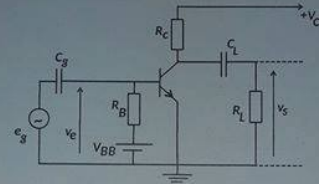


Figure 4: Circuit à base du transistor bipolaire

Étude statique

1. De quel type de montage s'agit-il? Quelle sont les propriétés d'un tel montage?
2. Quel sont les rôles des condensateurs C_g et C_L ?
3. Donner le schéma équivalent statique du montage.
4. Déterminer l'équation de la droite d'attaque, tracer la sur le document réponse 5 et placer alors le point de fonctionnement d'entrée P_{FE} . Quelles sont les coordonnées I_{B0} et V_{BE0} du point P_{FE} .
5. Sachant que le coefficient d'amplification en courant, du transistor 2N1711, $\beta = 150$, tracer caractéristique de transfert en courant $I_C = f(I_B)$.
6. Déterminer l'équation de la droite de charge, tracer la sur le document réponse 5 et placer alors le point de fonctionnement de sortie P_{FS} . Quelles sont les coordonnées I_{C0} et V_{CE0} du point P_{FS} .

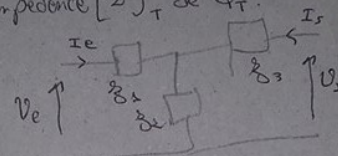
Étude dynamique

1. Donner le schéma équivalent du montage aux basses fréquences petits signaux.
2. Calculer l'amplification en tension A_v , sachant que $h_{12} = h_{22} = 0$.

CC 2016/2017: Electronique:

Exercice 1:

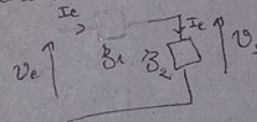
1/- Les parametres impédance $[Z]_T$ de Q_T .



$$\begin{pmatrix} v_e \\ v_s \end{pmatrix} = [Z_T] \begin{pmatrix} I_e \\ I_s \end{pmatrix}$$

$$Z_{11} = \frac{v_e}{I_e} \Big|_{I_s=0}$$

le circuit devient

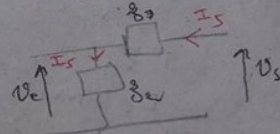


$$v_e = (Z_1 + Z_2) I_e$$

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2$$

$$Z_{21} = \frac{v_s}{I_e} \Big|_{I_s=0}$$

$$\text{on a } v_s = Z_3 I_e$$



$$Z_{21} = Z_3$$

$$Z_{12} = \frac{v_e}{I_s} \Big|_{I_e=0}$$

$$v_e = I_s Z_2 \Rightarrow Z_{12} = Z_2$$

$$Z_{12} = Z_2$$

$$Z_{22} = \frac{v_s}{I_s} \Big|_{I_e=0}$$

$$v_s = (Z_3 + Z_2) I_s$$

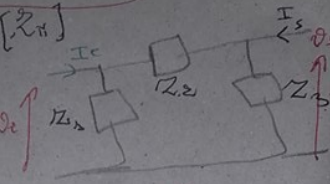
$$Z_{22} = Z_3 + Z_2$$

$$[Z_T]_{q_T} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{pmatrix}$$

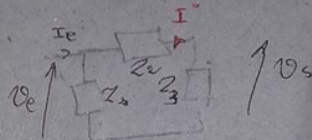
(2)

2/ les parametres impedance $[Z_{ij}]$

$$\begin{pmatrix} V_e \\ V_s \end{pmatrix} = [Z_T]_{q_T} \begin{pmatrix} I_e \\ I_s \end{pmatrix}$$



$$Z_{11} = \frac{V_e}{I_e} \Big|_{I_s=0}$$



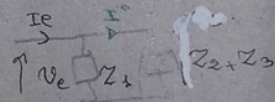
$$V_e = I_e Z_{eq}$$

$$Z_{eq} = (Z_2 + Z_3) \parallel Z_1$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{11} = \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{21} = \frac{V_s}{I_e} \Big|_{I_s=0}$$



$$V_s = I^* Z_3$$

calculons I^* (Deviser de courant)

$$I^* = I_e \frac{\frac{1}{Z_2 + Z_3}}{\frac{1}{Z_2 + Z_3} + \frac{1}{Z_1}} = I_e \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$\Rightarrow \frac{V_s}{I_e} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} = Z_{21}$$

$$Z_{12} = \frac{V_e}{I_s} \Big|_{I_e=0}$$

$$V_e = I^\circ Z_1$$

determinons I° (Divers courant)

$$I^\circ = \frac{I_s \frac{1}{Z_1 + Z_2}}{\frac{1}{Z_1 + Z_2} + \frac{1}{Z_3}} = \frac{I_s Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{12} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{22} = \frac{V_s}{I_s} \Big|_{I=0} \quad V_s = Z_{eq} I_s$$

$$Z_{eq} = (Z_2 + Z_1) \parallel Z_3 = \frac{Z_3 (Z_2 + Z_1)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$[Z_{ij}] = \begin{pmatrix} \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \\ \frac{Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_3 (Z_2 + Z_1)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{pmatrix}$$

$$3/- [Z_{ij}] = [Z_{ij}]$$

$$Z_1 \parallel (Z_2 + Z_3)$$

$$Z_1 + Z_2 = \frac{Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_2 = \frac{Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_3 + Z_2 = \frac{Z_3 \parallel (Z_2 + Z_1)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_1 = \frac{Z_3 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_2 = \frac{Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_3 = \frac{Z_3 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$\frac{1}{Z_{12}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2 + Z_3}$$

$$\frac{1}{Z_{22}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2 + Z_3}$$

$$\frac{1}{Z_{33}} = \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_2 + Z_1}$$

④

2/- analyse rapide,
ne dépend pas de fréquence.

pour les Base fréquence: $\omega \rightarrow 0$.
 $Z_c \rightarrow \infty$. $-11 \equiv \text{---} \circ \text{---}$ (Circuit ouvert)

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Le circuit devient.

3/- fonction du transport

Diviseur de Tension:

$$H(j\omega) = \frac{R_2}{Z_{eq} + R_2}$$

$$Z_{eq} = R_1 \parallel Z_{C_1} = \frac{R_1 / j\omega C_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$\frac{R_2}{1 + R_2 j\omega C_1}$$

$$Z_{eq} + R_2 = \frac{R_1 / j\omega C_1 + R_2 (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1})}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$\begin{aligned} \frac{R_2}{Z_{eq} + R_2} &= \frac{R_2 (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1})}{R_1 / j\omega C_1 + R_2 R_1 + R_2 / j\omega C_1} \\ &= \frac{R_2 (1 + j R_1 \omega C_1)}{R_2 + R_1 + j R_1 R_2 \omega C_1} \end{aligned}$$

$$H(j\omega) = H(0) \frac{1 + j R_1 \omega C_1}{1 + j \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \omega C_1}$$

$$\begin{aligned} H(0) &= \frac{R_2}{R_2 + R_1} \\ H(0) &= \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$H(j\omega) = H(0) H_1 H_2$$

$$H_1 = 1 + j \frac{\omega}{\omega_1} \quad \omega_1 = \frac{1}{R_1 C}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C} = 100 \text{ rad/s}$$

$$H_2 = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$$

$$\omega_2 = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2} = 10^4 \text{ rad/s}$$

4/ diagramme de Bode

étude de H_2 $H_2 = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$

$$\phi(\omega_1) = 0^\circ \text{ (3) droite horizontale } \omega > \omega_1 \text{ (7)}$$

Diagramme réel:

$$H(j\omega_1) = \frac{1}{10} \times \frac{1+j}{1+j0,1}$$

$$\|H(j\omega_1)\| = \frac{1}{10} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+(0,1)^2}} = 0,14$$

$$G_{dB} = 20 \log(0,14) = -16,99 \text{ dB}$$

$$\phi = \arg(H(j\omega_1)) = 0 + \arg(1) - \arg\left(\frac{0,1}{1}\right) = 44,42^\circ$$

$$P.F.A : \begin{cases} G_{dB} = -16,99 \\ \phi(\omega_1) = 44,42^\circ \end{cases}$$

$$H(j\omega_2) = \frac{1}{10} \times \frac{1+j100}{1+j}$$

$$\|H(j\omega_2)\| = \frac{1}{10} \times \frac{\sqrt{1+10000}}{\sqrt{2}} = 7,07$$

$$\begin{cases} G_{dB} = 20 \log \|H(j\omega_2)\| = 16,99 \text{ dB} \\ \phi(\omega_2) = 0 + \arg(100) - \arg(1) = 44,42^\circ \end{cases} B.$$

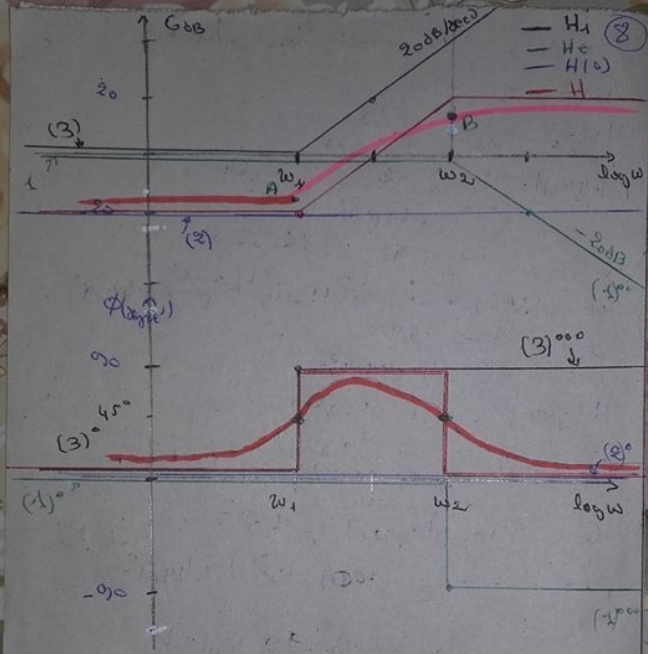
Diagramme de Bode

$$\log(\omega_2) = \log(100\omega_1) = 2 \log(\omega_1)$$

$$G_{dB}(H) = 20 \log |H| = 20 \log(H(\omega)) + 20 \log(H_1) - 20 \log(H_2)$$

$$\omega < \omega_1 : G_{dB} = -20 + 0 = -20$$

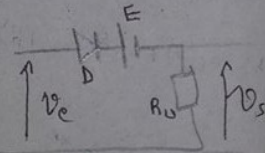
c/c : la diode constitue que des elts passifs, mais le gain en dB $\leq 0 \Rightarrow$ ce filtre n'existe pas.



Exercice 3 :

$$v_e = E_m \sin \omega t$$

1/ la diode est idéal
condition de conduction



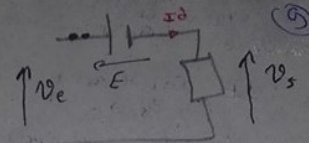
$$\begin{cases} v_D < 0 \\ i_D = 0 \end{cases} \text{ Bloquage}$$

$$\begin{aligned} &\text{circuit passant} \\ &i_D \geq 0 \\ &v_D = 0 \end{aligned} \rightarrow \text{circuit passant}$$

$$V_e = E + V_s$$

$$V_e = E + I_D R_0$$

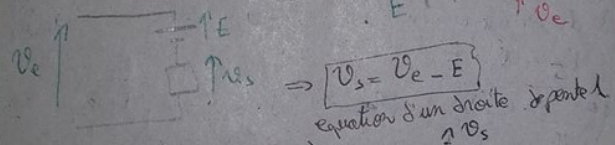
$$I_D = \frac{V_e - E}{R_0} > 0.$$



condition de conduction.
sachant que $V_e = E_m \sin \omega t$.

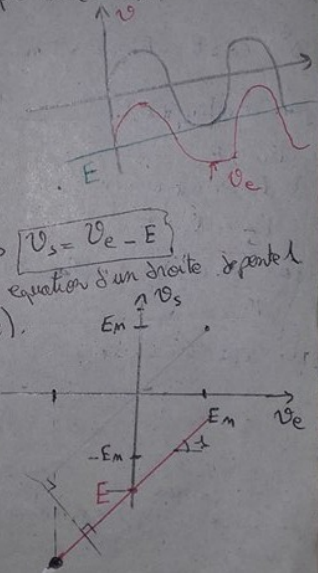
1^{er} cas: $E < -E_m$.

$V_e > E$ toujours
le circuit devient



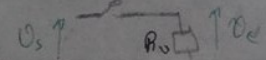
caractéristique $V_s = f(V_e)$.

$V_e = 0 \Rightarrow V_s = -E_m / -E_m$
la droite est décalée
alors parallèle à la droite
 $V_e = V_s$.

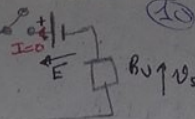


2^{em} cas: $E > +E_m$.

$I_D < 0 \Rightarrow$ la diode est bloquant. le circuit devient.

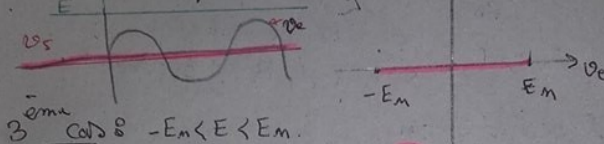


$I_d = 0$, circuit ouvert.



$V_s = 0$ car le courant $= 0$
 $V_s = R I = 0$

la caractéristique: $V_s = f(V_e)$



pour $\omega t \in [0, \pi - \theta_1]$.

$V_e > E$

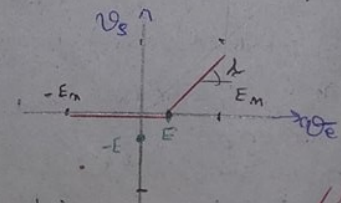
la diode est passant

$V_s = V_e - E$

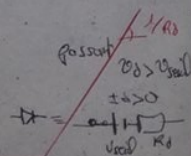
pour $\omega t \in [\pi - \theta_1, \pi + \theta_1]$ la diode est bloquant

$V_s = 0$

la caractéristique:



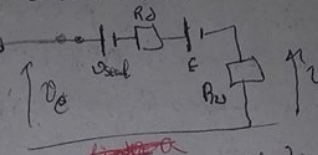
2/ 3ème approximation



Bloquant $I_d = 0$
 $V_d < V_{seuil}$

- On suppose que la diode est passant. (1.1)
 $I_D > 0 \Rightarrow V_D > V_{seuil}$. le circuit devient.

$$V_e = E + V_{seuil} + (R_D + R_U) I_D$$

$$I_D = \frac{V_e - (E + V_{seuil})}{R_D + R_U}$$


on a $V_{seuil} = V_{seuil} + V_{R_D} > V_{seuil}$ (+ je vérifie).
 $I_D > 0 \Rightarrow V_e > E + V_{seuil}$. - condition de conduction.

$V_e = E_m \sin \omega t$.

1^{er} cas: $E + V_{seuil} < -E_m$

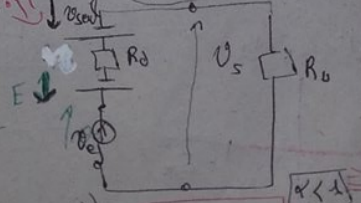
on a $V_e > E + V_{seuil}$.

la diode est passant:

le circuit devient

~~pas de fréquence~~ $\alpha < 1$

Milman:

$$V_s = \frac{V_e - (E + V_{seuil})}{\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_U}}$$


$$V_s = \frac{R_U}{R_D + R_U} (V_e - (E + V_{seuil})) = \alpha V_e + \beta$$

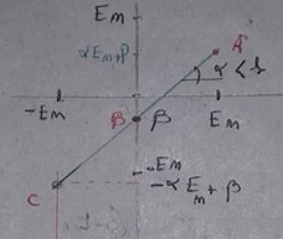
c'est une droite de pente α (croissant)

$\beta < 0 \Rightarrow V_s$ est sinusoidale

la caractéristique $V_s = f(V_e)$

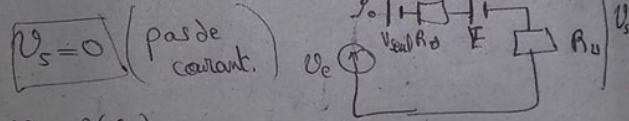
(12)

$$\begin{cases} V_e = 0 \Rightarrow V_s = \beta < 0 \quad (B) \\ V_e = E_m \Rightarrow V_s = \alpha E_m + \beta < E_m \quad (A) \\ V_e = -E_m \Rightarrow V_s = -\alpha E_m + \beta < -E_m \quad (C) \end{cases}$$

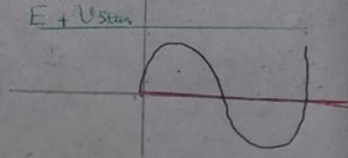
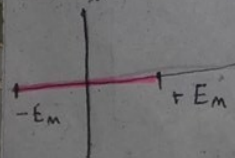


2^{ème} cas : $E + V_{seuil} > E_m$

la diode est Bloquante. le circuit devient.



$$V_s = f(V_e)$$



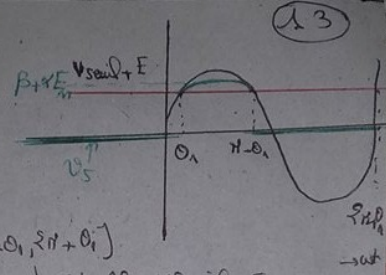
3^{ème} cas : $-E_m < V_{seuil} + E < +E_m$

• Si $\omega t \in [0, \pi - \theta_1]$.

le circuit est passant

car $v_e > v_{seuil} + E$.

$$v_s = \alpha v_e + \beta$$

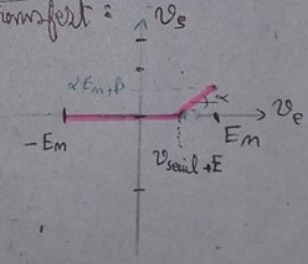


• Si $\omega t \in [\pi - \theta_1, 2\pi + \theta_1]$.

le circuit est bloquant car $v_e < v_{seuil} + E$.

par conséquent $\Rightarrow v_s = 0$

la caractéristique du transfert :



Exo 4 =

14

Etude statique :

1/ il s'agit du montage Emetteur commun.
 V_{ce} l'orientation est au niveau de Base, et V_{cs} sur collecteur.

les propriétés d'un tel montage
 - rendre le transistor un quadripôle
 =

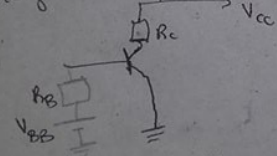
2/ les condensateurs C_0 et C_L sont condensateurs de liaison, leur rôle est de séparer les grandeurs continues des alternatifs.

• en statique C_0 et $C_L \sim \infty$

• régime dynamique C_0 et $C_L \sim \text{circuit ouvert}$

3/ le schéma équivalent :: $\omega = 0$.

Régime statique $Z_{C_0} Z_{C_L} \rightarrow \infty$. \Rightarrow

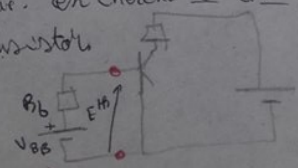


4- la droite d'attaque. on cherche E^{th} et R^{th}
 vu de l'entrée du transistor

$$R^{th} = R_B$$

$$E^{th} = V_{BB}$$

(se calcule à vide, $I = 0$)



droite d'attaque.

$$I_B = \beta(V_{BE})$$

loi des mail.

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{1,25 - V_{BE}}{1000} \quad (DA)$$



Equation d'une droite de pente $-\frac{1}{1000}$.

pt A: $I_B = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} V_{BE} = 0 \\ V_{BE} = 1,25 \end{array} \right.$ $\text{pt B: } \left\{ \begin{array}{l} V_{BE} = 0 \\ I_B = \frac{1,25}{1000} \end{array} \right.$

en represente la droite le pt de fonctionnement est l'intersection de droite d'attaque avec $I_B = \beta(V_{BE})$.

5/ $I_C = \beta I_B = 150 I_B$.

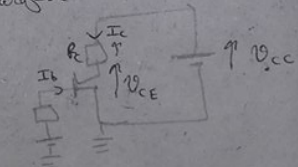
c'est une equation d'une droite de pente 150.
passe par ($I_C = 0, I_B = 0$).

6/ l'equation de charge:
à la sortie

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

$$I_C = \frac{12 - V_{CE}}{800}$$



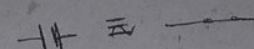
Equation d'une droite de pente $-\frac{1}{800}$.

pt A: $I_C = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} V_{CE} = 12 \\ V_{CE} = 12 \end{array} \right.$

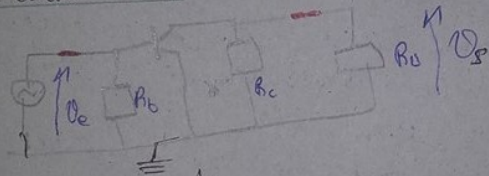
pt B: $V_{CE} = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} I_C = \frac{12}{800} \end{array} \right.$

les coordonnées de P_{FS} est l'intersection ^{et 6}
de la droite de charge et $I_C = \beta(V_{BE})$.
(déterminé à partir de I_{B0})

Etude dynamique

1. pour les signaux \rightarrow  ^{coeur} _{circuit}
le montage dérivé. (on élimine les sources
continue).

le circuit dérivé :



2. calculons A_v .
le transistor est équivalent à (petit signal.)
un quadripôle dont la représentation hybride
 $V_{BE} = h_{11} I_B + h_{12} V_{CE}$
 $I_C = h_{21} I_B + h_{22} V_{CE}$
on a $h_{12} = h_{22} = 0$. le circuit dérivé.

